

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関  
国際事務局



(43)国際公開日  
2004年7月15日 (15.07.2004)

PCT

(10)国際公開番号  
WO 2004/059392 A1

(51) 国際特許分類 <sup>7</sup> :	G03F 7/039	奈川県 川崎市 中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP).
(21) 国際出願番号:	PCT/JP2003/016266	(74) 代理人: 棚井 澄雄, 外(TANAI,Sumio et al.); 〒104-8453 東京都中央区八重洲2丁目3番1号 Tokyo (JP).
(22) 国際出願日:	2003年12月18日 (18.12.2003)	(81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(25) 国際出願の言語:	日本語	(84) 指定国(広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
(26) 国際公開の言語:	日本語	
(30) 優先権データ: 特願 2002-376294	2002年12月26日 (26.12.2002) JP	

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 東京応化工業株式会社 (TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.) [JP/JP]; 〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 Kanagawa (JP).

(72)発明者; および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 佐藤 和史 (SATO,Kazufumi) [JP/JP]; 〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 萩原 三雄 (HAGIHARA,Mitsuo) [JP/JP]; 〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 川名 大助 (KAWANA,Daisuke) [JP/JP]; 〒211-0012 神

添付公開書類:  
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

(54) Title: POSITIVE RESIST COMPOSITION AND METHOD FOR FORMING RESIST PATTERN

(54)発明の名称: ポジ型レジスト組成物およびレジストパターン形成方法

(57) Abstract: A positive resist composition containing a resin component (A) which has a group suppressing the solubility thereof into an alkali and undergoing dissociation on the action of an acid and thus exhibits such alkali solubility that is increased by the action of an acid, and an acid generating component (B) which generates an acid on the exposure to a light, wherein the resin component (A) is a copolymer comprising a first constituting unit (a1) derived from hydroxystyrene and a second constituting unit (a2) derived from a (meth)acrylate ester having an alcoholic hydroxyl group, wherein 10 to 25 mole % of the sum of the hydroxyl group in the constituting unit (a1) and the alcoholic hydroxyl group in the constituting unit (a2) is protected by the above-mentioned group, and wherein the copolymer before the protection by the above-mentioned group has a mass average molecular mass of 2000 to 8500; and a method for forming a pattern using the positive resist composition. The positive resist composition allows the achievement of the reduction of the development defect in combination with good performance for resolution.

(57)要約: 良好的な解像性能が得られるとともに、現像欠陥を低減させることができるポジ型レジスト組成物、および該ポジ型レジスト組成物を用いたパターン形成方法を提供する。このポジ型レジスト組成物は、酸解離性溶解抑制基を有し、酸の作用によりアルカリ可溶性が増大する樹脂成分(A)と、露光により酸を発生する酸発生剤成分(B)とを含むポジ型レジスト組成物において、樹脂成分(A)が、ヒドロキシスチレンから誘導される第1の構成単位(a1)、およびアルコール性水酸基を有する(メタ)アクリル酸エステルから誘導される第2の構成単位(a2)を含む共重合体であって、前記構成単位(a1)の水酸基と前記構成単位(a2)のアルコール性水酸基との合計の10モル%以上25モル%以下が前記酸解離性溶解抑制基により保護されており、前記酸解離性溶解抑制基で保護される前の共重合体の質量平均分子量が2000以上8500以下である。

WO 2004/059392 A1